

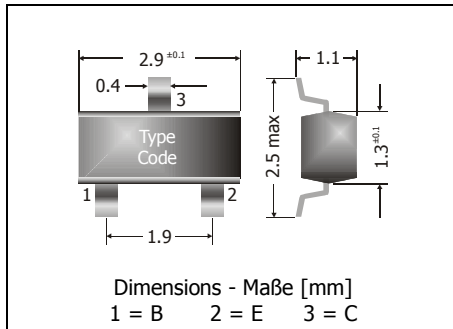
BFS20

NPN

Surface Mount Si-Epi-Planar Transistors
Si-Epi-Planar Transistoren für die Oberflächenmontage

NPN

Version 2012-11-26



Power dissipation – Verlustleistung

200 mW

Plastic case
KunststoffgehäuseSOT-23
(TO-236)

Weight approx. – Gewicht ca.

0.01 g

Plastic material has UL classification 94V-0
Gehäusematerial UL94V-0 klassifiziertStandard packaging taped and reeled
Standard Lieferform getupet auf Rolle
Maximum ratings (T_A = 25°C)
Grenzwerte (T_A = 25°C)

			BFS20
Collector-Emitter-volt. – Kollektor-Emitter-Spannung	B open	V _{CEO}	20 V
Collector-Base-volt. – Kollektor-Base-Spannung	E open	V _{CBO}	30 V
Emitter-Base-voltage – Emitter-Basis-Spannung	C open	V _{EBO}	4 V
Power dissipation – Verlustleistung		P _{tot}	200 mW ¹⁾
Collector current – Kollektorstrom (dc)		I _C	25 mA
Junction temperature – Sperrschichttemperatur		T _j	-55...+150°C
Storage temperature – Lagerungstemperatur		T _S	-55...+150°C

Characteristics (T_j = 25°C)
Kennwerte (T_j = 25°C)

		Min.	Typ.	Max.
DC current gain – Kollektor-Basis-Stromverhältnis ²⁾				
V _{CE} = 10 V, I _C = 7 mA	h _{FE}	40	–	140
Collector cutoff current – Kollektor-Reststrom				
V _{CB} = 20 V	I _{CB0}	–	–	100 nA
Emitter-cutoff current – Emitter-Reststrom				
V _{EB} = 4 V	I _{EB0}	–	–	100 μA

1 Valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 2 mm from case

Gültig wenn die Anschlussdrähte in 2 mm Abstand vom Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden

2 Tested with pulses t_p = 300 μs, duty cycle ≤ 2% – Gemessen mit Impulsen t_p = 300 μs, Schaltverhältnis ≤ 2%

Characteristics (T_j = 25°C)
Kennwerte (T_j = 25°C)

		Min.	Typ.	Max.
Base-Emitter-voltage – Basis-Emitter-Spannung ¹⁾ V _{CE} = 10 V, - I _C = 7 mA				0.9 V
Gain-Bandwidth Product – Transitfrequenz V _{CE} = 10 V, I _C = 5 mA, f = 100 MHz		275 MHz	450 MHz	–
Collector-Base Capacitance – Kollektor-Basis-Kapazität V _{CB} = 10 V, I _E = i _e = 0, f = 1 MHz		–	1 pF	–
Thermal resistance junction to ambient air Wärmewiderstand Sperrschicht – umgebende Luft		< 420 K/W ²⁾		
Marking - Stempelung		BFS20 = 80		

1 Tested with pulses t_p = 300 μs, duty cycle ≤ 2% – Gemessen mit Impulsen t_p = 300 μs, Schaltverhältnis ≤ 2%

2 Mounted on P.C. board with 3 mm² copper pad at each terminal
Montage auf Leiterplatte mit 3 mm² Kupferbelag (Löt-pad) an jedem Anschluss

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Bipolar Transistors - BJT category](#):

Click to view products by [Diodec manufacturer](#):

Other Similar products are found below :

[619691C](#) [MCH4017-TL-H](#) [MJ15024/WS](#) [MJ15025/WS](#) [BC546/116](#) [BC556/FSC](#) [BC557/116](#) [BSW67A](#) [HN7G01FU-A\(T5L,F,T](#)
[NJVMJD148T4G](#) [NSVMMBT6520LT1G](#) [NTE187A](#) [NTE195A](#) [NTE2302](#) [NTE2330](#) [NTE2353](#) [NTE316](#) [IMX9T110](#) [NTE63](#) [NTE65](#)
[C4460](#) [SBC846BLT3G](#) [2SA1419T-TD-H](#) [2SA1721-O\(TE85L,F\)](#) [2SA1727TLP](#) [2SA2126-E](#) [2SB1202T-TL-E](#) [2SB1204S-TL-E](#) [2SC5488A-](#)
[TL-H](#) [2SD2150T100R](#) [SP000011176](#) [FMC5AT148](#) [2N2369ADCSM](#) [2SB1202S-TL-E](#) [2SC2412KT146S](#) [2SC4618TLN](#) [2SC5490A-TL-H](#)
[2SD1816S-TL-E](#) [2SD1816T-TL-E](#) [CMXT2207 TR](#) [CPH6501-TL-E](#) [MCH4021-TL-E](#) [BC557B](#) [TTC012\(Q\)](#) [BULD128DT4](#) [JANTX2N3810](#)
[Jantx2N5416](#) [US6T6TR](#) [KSF350](#) [068071B](#)